

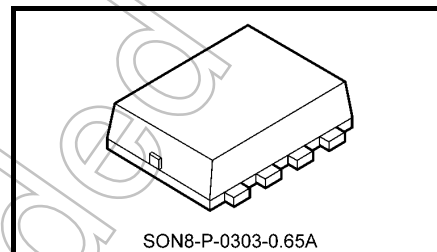
TCV7106FN

降圧型DC-DCコンバータIC

TCV7106FN は降圧型 DC-DC コンバータ用 1 チップ IC です。
高速・低オン抵抗のパワーMOS FET を内蔵しており、同期整流とチョップ方式の切り換えが可能で、広い出力電流範囲で高効率が得られます。

特 長

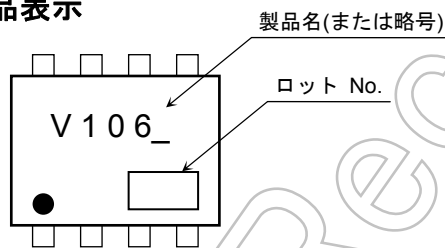
- 少ない外付け部品で大電流ドライブが可能です。
 $I_{OUT} = 2.5A(\text{最大}) (@ V_{IN} = 5V) / 2A(\text{最大}) (@ V_{IN} = 3.3V)$
- 高効率: $\eta = 95\%$ (標準)(同期整流モード@ $V_{IN} = 5V, V_{OUT} = 3.3V, I_{OUT} = 0.7A$)
- 同期整流方式とチョップ方式の切り換え動作が可能で、広い出力電流範囲で高効率が得られます。
- 動作入力電圧: $V_{IN} = 2.7V \sim 5.6V$
- 低オン抵抗: $R_{DS(ON)} = 0.18\Omega / 0.12\Omega(\text{標準}) (@ \text{ハイサイド/ローサイド}, V_{IN} = 5V, T_J = 25^\circ C)$
- 発振周波数: $f_{OSC} = 550 \text{ kHz}(\text{標準})$
- 基準電圧: $V_{FB} = 0.8V \pm 1\% (@ T_J = 0 \sim 85^\circ C)$
- 内部位相補償方式を採用しているため、少ない外付け部品で高効率の電源を実現できます。
- 出力平滑用コンデンサに小型のセラミックコンデンサが使用可能です。
- 低熱抵抗の小型面実装パッケージ(PS-8)を採用しています。



SON8-P-0303-0.65A

質量: 0.017 g (標準)

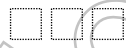
現品表示



正面から見てマーク左下のドット (●) が
1 番端子を示しています。

ロット No.

3 桁算用数字で構成し、西暦年号の末尾 1 桁、および残りの 2 桁は製造週とする。

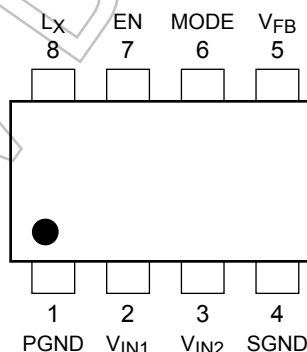


製造週コード (その年の第一週を 01 とし、以降 52 または 53 まで)

製造年コード (西暦の末尾 1 桁)

製品名末尾の “_” はフィードバック端子電圧検出機能を付加した製品を示します。

端子配置図



この製品は MOS 構造ですので取り扱いの際には静電気にご注意ください。

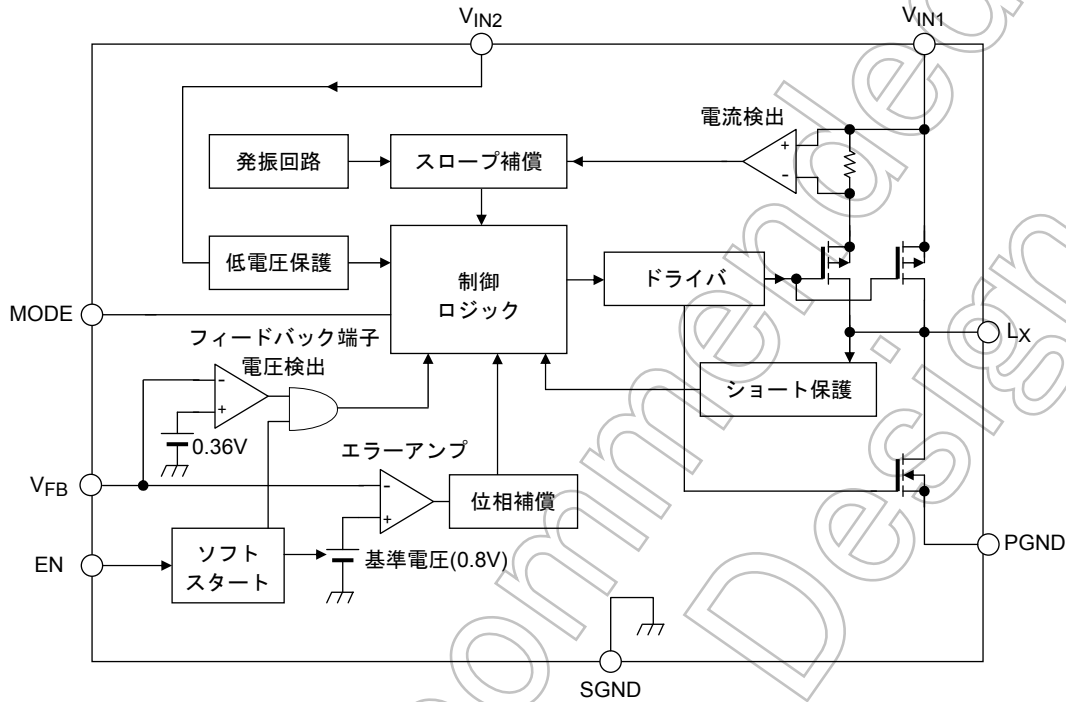
本製品に内蔵される保護機能は、短時間の過電流、過熱など、一時的かつわずかな程度に過剰な負荷から本製品を保護するための機能であり、いかなる場合でも本製品を保護するというものではありません。本製品をお客様のシステムに使用する場合は、本製品への上記負荷を回避しかつ上記負荷が発生次第直ちに上記負荷を解除するようお客様のシステムを設計してください。

製品量産開始時期
2010-03

オーダー方法

製品名	包装形態と発注単位
TCV7106FN (TE85L, F)	エンボステープング: (3000 個/リール)

ブロック図



端子説明

端子番号	端子記号	端子の説明
1	PGND	出力部接地端子
2	V _{IN1}	出力部入力端子 V _{EN} =L となるとスタンバイ状態となり、消費電流は 10 μ A 以下となります。
3	V _{IN2}	制御部入力端子 V _{EN} =L となるとスタンバイ状態となり、消費電流は 10 μ A 以下となります。
4	SGND	制御部接地端子
5	V _{FB}	フィードバック端子 0.8V(標準)の基準電圧に接続された、エラーアンプを内蔵しています。
6	MODE	モード切り換え端子 1.5V 以上(@V _{IN} =5V)の電圧が印加されると同期整流モードが選択され、内蔵ローサイド FET が動作し、PWM モードで動作します。 0.5V(@V _{IN} =5V)以下の電圧が印加されるとチョップモードが選択され、内蔵ローサイド FET が OFF になります。このモードを使用するときは、L _X - PGND 端子間にショットキバリアダイオードを接続してください。 この端子は動作中に 1.2 μ A(標準)でプルアップされます。
7	EN	イネーブル端子 1.5V 以上(@V _{IN} =5V)の電圧が印加されると内部回路が起動し、スイッチング動作が開始されます。0.5V(@V _{IN} =5V)以下の電圧で、内部回路の動作を停止しスタンバイモードになります。 この端子は約 500k Ω のプルダウン抵抗を内蔵しています。
8	L _X	スイッチング端子 ハイサイドの Pch MOS FET とローサイドの Nch MOS FET が接続されています。

絶対最大定格 (Ta = 25°C) (注)

項 目	記 号	定 格	単位
出力部入力端子電圧(注1)	V _{IN1}	-0.3~7	V
制御部入力端子電圧(注1)	V _{IN2}	-0.3~7	V
フィードバック端子電圧(注1)	V _{FB}	-0.3~7	V
イネーブル端子電圧(注1)	V _{EN}	-0.3~7	V
モード端子電圧(注1)	V _{MODE}	-0.3~7	V
イネーブル・入力端子間電圧	V _{EN} -V _{IN2}	V _{EN} -V _{IN2} <0.3	V
モード・入力端子間電圧	V _{MODE} -V _{IN2}	V _{MODE} -V _{IN2} <0.3	V
スイッチング端子電圧(注2)	V _{LX}	-0.3~7	V
スイッチング端子電流	I _{LX}	±2.9	A
許 容 損 失(注3)	P _D	0.9	W
動作接合部温度	T _{jopr}	-40~125	°C
接合部温度(注4)	T _j	150	°C
保 存 温 度	T _{stg}	-55~150	°C

熱抵抗特性

項 目	記 号	最 大	単位
接合部 - 外気間熱抵抗	R _{th(j-a)}	110.2(注3)	°C/W

注: 本製品の使用条件(使用温度/電流/電圧等)が絶対最大定格/動作範囲以内での使用においても、高負荷(高温および大電流/高電圧印加、多大な温度変化等)で連続して使用される場合は、信頼性が著しく低下する恐れがあります。

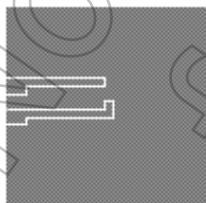
弊社半導体信頼性ハンドブック(取り扱い上のご注意とお願いおよびディレーティングの考え方と方法)および個別信頼性情報(信頼性試験レポート、推定故障率等)をご確認の上、適切な信頼性設計をお願いします。

注1: 本製品の使用条件が絶対最大定格以内での使用においても連続して使用される場合は、信頼性が著しく低下する恐れがあります。ディレーティングを考慮し、各端子の動作入力電圧は5.6V以下でご使用ください。

注2: スwitchング端子電圧(V_{LX})は本製品のスイッチングによって発生するピーク電圧を含まない値です。スイッチング素子のデッドタイム時に発生する負電圧は、スイッチング端子電流(I_{LX})の範囲で許容されます。

注3:

片面ガラスエポキシ基板



材質: FR-4
25.4 × 25.4 × 0.8
(単位: mm)

注4: 最大接合部温度では過熱保護回路が作動することがあります。最大動作接合部温度を超えることのない放熱条件でご使用ください。

電氣的特性 (T_J = 25°C、条件がないものについては、V_{IN1} = V_{IN2} = 2.7V~5.6V)

項 目	記 号	測 定 条 件	最小	標準	最大	単位
動 作 入 力 電 圧	V _{IN(OPR)}	—	2.7	—	5.6	V
消 費 電 流	I _{IN}	V _{IN1} = V _{IN2} = V _{EN} = V _{FB} = 5V V _{MODE} = 5V	—	450	680	μA
出 力 可 能 電 圧 範 囲	V _{OUT(OPR)}	V _{EN} = V _{IN1} = V _{IN2}	0.8	—	—	V
ス タ ン バ イ 電 流	I _{IN(STBY)1}	V _{IN1} = V _{IN2} = 5V, V _{EN} = 0V V _{FB} = 0.8V	—	—	10	μA
	I _{IN(STBY)2}	V _{IN1} = V _{IN2} = 3.3V, V _{EN} = 0V V _{FB} = 0.8V	—	—	10	
ハイサイドスイッチリーク電流	I _{LEAK(H)}	V _{IN1} = V _{IN2} = 5V, V _{EN} = 0V V _{FB} = 0.8V, V _{LX} = 0V	—	—	10	μA
イ ネ ー ブ ル 端 子 し き い 値 電 圧	V _{IH(EN)1}	V _{IN1} = V _{IN2} = 5V	1.5	—	—	V
	V _{IH(EN)2}	V _{IN1} = V _{IN2} = 3.3V	1.5	—	—	
	V _{IL(EN)1}	V _{IN1} = V _{IN2} = 5V	—	—	0.5	
	V _{IL(EN)2}	V _{IN1} = V _{IN2} = 3.3V	—	—	0.5	
イ ネ ー ブ ル 端 子 電 流	I _{IH(EN)1}	V _{IN1} = V _{IN2} = 5V, V _{EN} = 5V	6	—	13	μA
	I _{IH(EN)2}	V _{IN1} = V _{IN2} = 3.3V, V _{EN} = 3.3V	4	—	9	
モ ー ド 端 子 し き い 値 電 圧	V _{IH(MODE)}	V _{IN1} = V _{IN2} = 5V	1.5	—	—	V
	V _{IL(MODE)}	V _{IN1} = V _{IN2} = 5V	—	—	0.5	
モ ー ド 端 子 電 流	I _{IH(MODE)}	V _{IN1} = V _{IN2} = 5V, V _{EN} = 5V	—	-1.2	-2.5	μA
フ ィ ー ド バ ッ ク 端 子 電 圧	V _{FB1}	V _{IN1} = V _{IN2} = 5V, V _{EN} = 5V T _J = 0~85°C	0.792	0.8	0.808	V
	V _{FB2}	V _{IN1} = V _{IN2} = 3.3V, V _{EN} = 3.3V T _J = 0~85°C	0.792	0.8	0.808	
フ ィ ー ド バ ッ ク 端 子 電 流	I _{FB}	V _{IN1} = V _{IN2} = 2.7V~5.6V V _{FB} = V _{IN2}	-1	—	1	μA
ハイサイドスイッチオン抵抗	R _{DS(ON)(H)1}	V _{IN1} = V _{IN2} = 5V, V _{EN} = 5V I _{LX} = -1A	—	0.18	—	Ω
	R _{DS(ON)(H)2}	V _{IN1} = V _{IN2} = 3.3V, V _{EN} = 3.3V I _{LX} = -1A	—	0.21	—	
	R _{DS(ON)(H)3}	V _{IN1} = V _{IN2} = 5V, V _{EN} = 5V I _{LX} = -0.1A, T _J = -40~85°C	—	—	0.25	
	R _{DS(ON)(H)4}	V _{IN1} = V _{IN2} = 3.3V, V _{EN} = 3.3V I _{LX} = -0.1A, T _J = -40~85°C	—	—	0.3	
ローサイドスイッチオン抵抗	R _{DS(ON)(L)1}	V _{IN1} = V _{IN2} = 5V, V _{EN} = 5V I _{LX} = -1A	—	0.12	—	Ω
	R _{DS(ON)(L)2}	V _{IN1} = V _{IN2} = 3.3V, V _{EN} = 3.3V I _{LX} = -1A	—	0.14	—	
	R _{DS(ON)(L)3}	V _{IN1} = V _{IN2} = 5V, V _{EN} = 5V I _{LX} = -0.1A, T _J = -40~85°C	—	—	0.18	
	R _{DS(ON)(L)4}	V _{IN1} = V _{IN2} = 3.3V, V _{EN} = 3.3V I _{LX} = -0.1A, T _J = -40~85°C	—	—	0.2	
発 振 周 波 数	f _{OSC}	V _{IN1} = V _{IN2} = V _{EN} = 5V	450	550	650	kHz
内 部 ソ フ ト ス タ ー ト 時 間	t _{SS}	V _{IN1} = V _{IN2} = 5V, I _{OUT} = 0A V _{OUT} が 90%となるまでの時間	3	4.5	6	ms
ハイサイドスイッチオンデューティ	D _{max}	V _{IN1} = V _{IN2} = 2.7V~5.6V	—	—	100	%
過 熱 保 護	検 出 温 度	T _{SD}	V _{IN1} = V _{IN2} = 5V	—	150	°C
	ヒステリシス	ΔT _{SD}	V _{IN1} = V _{IN2} = 5V	—	15	
低 電 圧 保 護	検 出 電 圧	V _{UV}	V _{EN} = V _{IN1} = V _{IN2}	2.3	2.45	V
	解 除 電 圧	V _{UVR}	V _{EN} = V _{IN1} = V _{IN2}	2.4	2.55	
	ヒステリシス	ΔV _{UV}	V _{EN} = V _{IN1} = V _{IN2}	—	0.1	
スイッチング端子ピーク電流制限	I _{LIM1}	V _{IN1} = V _{IN2} = 4.3V, V _{OUT} = 2V	2.7	3.3	—	A
	I _{LIM2}	V _{IN1} = V _{IN2} = 3.3V, V _{OUT} = 2V	2.3	2.9	—	
フ ィ ー ド バ ッ ク 端 子 検 出 電 圧	V _{OLD}	V _{EN} = V _{IN1} = V _{IN2}	—	0.36	—	V

電氣的特性共通事項

各項目測定条件内の $T_j = 25^\circ\text{C}$ とは、パルス試験を実施しチップの接合部温度上昇による特性値のドリフトを無視できる状態での規定です。

応用回路例

C_{OUT} に低 ESR の電解コンデンサまたはセラミックコンデンサを使用した標準的な応用例

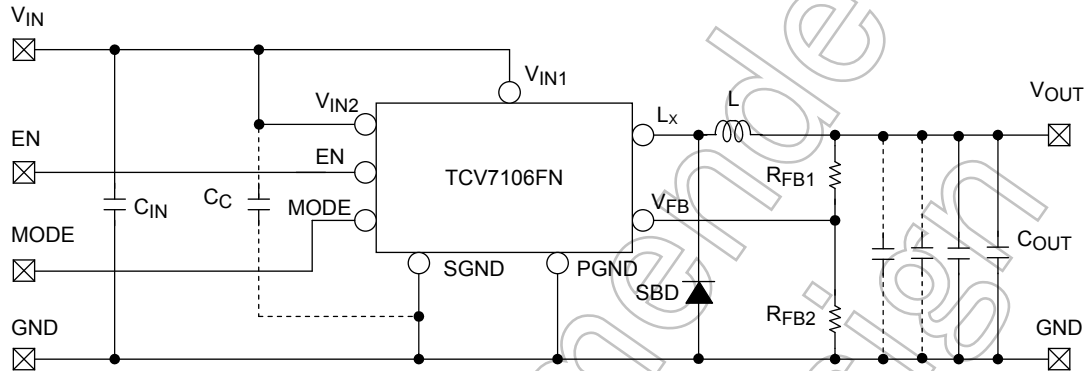


図 1 TCV7106FN 応用回路例

部品定数 (参考値@ $V_{IN} = 5\text{V}$, $V_{OUT} = 3.3\text{V}$, $T_a = 25^\circ\text{C}$)

- C_{IN} : 入力平滑用コンデンサ $10\mu\text{F}$ (セラミックコンデンサ: 株式会社村田製作所 GRM21BB30J106K
または TDK-EPC 株式会社 C2012X5R1C106M)
- C_{OUT} : 出力平滑用コンデンサ $10\mu\text{F}$ (セラミックコンデンサ: 株式会社村田製作所 GRM21BB30J106K
または TDK-EPC 株式会社 C2012X5R1C106M)
- R_{FB1} : 出力電圧設定用抵抗 $7.5\text{k}\Omega$
- R_{FB2} : 出力電圧設定用抵抗 $2.4\text{k}\Omega$
- L : インダクタ $4.7\mu\text{H}$ (TDK-EPC 株式会社 CLF7045T-4R7N
または 東光株式会社 D63CB #A916CY-4R7M)
- SBD : ショットキバリアダイオード (株式会社東芝 CRS30I30A)

C_C は制御部入力端子のデカップリングコンデンサです。

(基板レイアウトや C_{IN} の特性の影響などにより、動作が不安定になる場合に接続してください)

同期整流モード(MODE=H)に固定して使用する場合、SBD は省略できます。

部品定数設定例 (参考値)

出力電圧設定 V_{OUT}	インダクタンス L	入力平滑 コンデンサ容量 C_{IN}	出力平滑 コンデンサ容量 C_{OUT}	フィードバック抵抗 R_{FB1}	フィードバック抵抗 R_{FB2}
1.0 V	$4.7\mu\text{H}$	$10\mu\text{F}$	$40\mu\text{F}$	$7.5\text{k}\Omega$	$30\text{k}\Omega$
1.2 V	$4.7\mu\text{H}$	$10\mu\text{F}$	$30\mu\text{F}$	$7.5\text{k}\Omega$	$15\text{k}\Omega$
1.51 V	$4.7\mu\text{H}$	$10\mu\text{F}$	$30\mu\text{F}$	$16\text{k}\Omega$	$18\text{k}\Omega$
1.8 V	$4.7\mu\text{H}$	$10\mu\text{F}$	$30\mu\text{F}$	$15\text{k}\Omega$	$12\text{k}\Omega$
2.5 V	$4.7\mu\text{H}$	$10\mu\text{F}$	$20\mu\text{F}$	$5.1\text{k}\Omega$	$2.4\text{k}\Omega$
3.3 V	$4.7\mu\text{H}$	$10\mu\text{F}$	$20\mu\text{F}$	$7.5\text{k}\Omega$	$2.4\text{k}\Omega$

部品定数は、入出力条件および基板レイアウト等により設定が必要です。

応用方法

インダクタの選定

インダクタンスは、(1) 式より求められます。

$$L = \frac{V_{IN} - V_{OUT}}{f_{osc} \cdot \Delta I_L} \cdot \frac{V_{OUT}}{V_{IN}} \quad \dots\dots\dots (1)$$

V_{IN} : 入力電圧 (V) f_{osc} : 発振周波数 (Hz) = 550kHz (標準)
 V_{OUT} : 出力電圧 (V) ΔI_L : インダクタのリプル電流 (A)

- *: 通常、 ΔI_L は最大出力電流の 25%程度に設定します。本製品では、出力電流 $I_{OUT} = 2.5A$ (最大であるため、 ΔI_L は 0.6 A 程度になります。インダクタの定格電流はピーク電流となる 2.8A 以上の製品を選定してください。インダクタの定格電流を越えた場合、インダクタが磁気飽和して DC-DC コンバータとしての動作が不安定になる恐れがあります。

$V_{IN} = 5V$, $V_{OUT} = 3.3V$ の条件では、次のようにインダクタンスを算出できます。インダクタンスは入力電圧範囲を考慮して最適な定数を設定してください。

$$\begin{aligned}
 L &= \frac{V_{IN} - V_{OUT}}{f_{osc} \cdot \Delta I_L} \cdot \frac{V_{OUT}}{V_{IN}} \\
 &= \frac{5V - 3.3V}{550kHz \cdot 0.6A} \cdot \frac{3.3V}{5V} \\
 &= 3.4 \mu H
 \end{aligned}$$

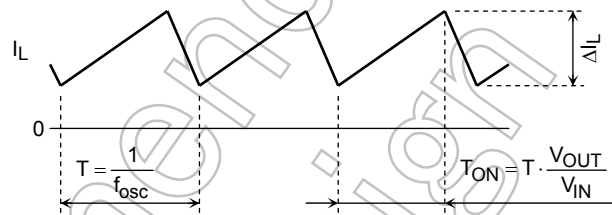


図 2 インダクタ電流波形

出力電圧の設定

本製品は、フィードバック端子(V_{FB})に接続されたエラーアンプの基準電圧 0.8V (標準) を基に、 R_{FB1} と R_{FB2} の分割抵抗によって出力電圧を設定します。出力電圧は (2) 式から求められます。なお、 R_{FB1} の値が極端に大きい場合には、フィードバック端子の寄生容量により遅れ時間が発生しますので、 R_{FB1} は 30k Ω 程度を最大としてください。出力電圧精度を確保するため $\pm 1\%$ 以下の高精度抵抗の使用を推奨します。

$$\begin{aligned}
 V_{OUT} &= V_{FB} \cdot \left(1 + \frac{R_{FB1}}{R_{FB2}} \right) \\
 &= 0.8V \cdot \left(1 + \frac{R_{FB1}}{R_{FB2}} \right) \quad \dots\dots\dots (2)
 \end{aligned}$$

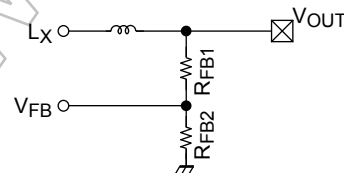


図 3 出力電圧設定抵抗

整流素子の選定

本製品はチョップモード(MODE=L)を選択すると、ローサイドの内蔵 MOSFET を常時 OFF し、チョップ方式の DC-DC コンバータとして使用することができます。チョップモードで使用する場合は L_X 端子 PGND 端子間に整流素子としてショットキバリアダイオードを接続してください。ショットキバリアダイオードには CRS30I30A 相当をご使用ください。ショットキバリアダイオードは周囲温度の上昇や電流による自己発熱により、逆電流が増加し損失が増える傾向にありますので、ディレーティングを考慮し定格に余裕のあるものを選定してください。

同期整流モード(MODE=H)に固定した状態で使用する場合は外付けの整流素子は不要です。

出力平滑用コンデンサの選定

出力平滑用コンデンサは、低 ESR の電解コンデンサまたはセラミックコンデンサを使用してください。コンデンサの特性は温度により影響を受けますので、温度特性が良好な製品を選定してください。また、容量値は出力電圧 2V 以上の設定では 20 μ F 以上、2V 未満の設定では、30 μ F 以上を目安とし、セット規格のリプル電圧と、負荷応答特性を満足するような最適な容量値を選定してください。出力電圧設定値が低い程、位相余裕度が少なくなる傾向があります。位相余裕度が不足する場合や、負荷応答特性を満足できない場合は、出力平滑用コンデンサの容量値を大きくしてください。なお、セラミックコンデンサは ESR（等価直列抵抗）が非常に小さいため、出力電圧リプルを低減できますが、位相余裕度が少なくなりますので、十分な評価を実施してご使用ください。

ソフトスタート機能

本製品は出力電圧のソフトスタート機能を内蔵しています。内部ソフトスタート時間 $t_{SS} = 4.5\text{ms}$ （標準）によって出力電圧の供給を開始します。ソフトスタート動作は電源立ち上げによる低電圧保護解除時、もしくはイネーブル端子電圧が L $\rightarrow$ H となったときの出力電圧供給開始時に行います。

モード切り換え機能

本製品は同期整流モード(MODE=H)と、チョップモード(MODE=L)を切り換えて使用できます。チョップモードで使用するときはローサイド素子として外付けのショットキバリアダイオードを接続してください。同期整流モードでは大きい出力電流で高効率が得られます。チョップモードは約 100mA より小さい出力電流で、同期整流モードより高効率が得られますが、出力リップル電圧が増大しますのでご注意ください。同期整流モードとチョップモードとの切り換えは常時可能ですが、切り換え時に出力電圧変動があり、パルススキップ動作となる出力電流が少ない領域では、変動量が大きくなる傾向があります。変動量がセット規格を満たすよう十分な評価を実施してご使用ください。

過電流保護機能

本製品は垂下型過電流保護機能を内蔵しています。Lx 端子電流のピーク値が、スイッチング端子ピーク電流制限 $I_{LIM1} = 3.3\text{A}$ （標準）@ $V_{IN} = 4.3\text{V}$ / $I_{LIM2} = 2.9\text{A}$ （標準）@ $V_{IN} = 3.3\text{V}$ を超えると、ハイサイドスイッチング素子の ON 時間を制限し出力電圧を低下させます。 $V_{IN} \geq 4.3\text{V}$ の条件では $I_{OUT} = 2.5\text{A}$ （最大）で使用できます。

$V_{IN} < 4.3\text{V}$ の条件では $I_{OUT} = 2\text{A}$ （最大）でご使用ください。

フィードバック端子電圧検出機能

本製品はフィードバック端子電圧検出機能を内蔵しています。フィードバック端子の電圧が、フィードバック端子検出電圧 $V_{OLD} = 0.36\text{V}$ （標準）以下の状態を検出すると、65 μ s（標準）後に出力電圧を停止し、フィードバック端子の地絡などによる出力電圧の土昇を抑えます。また、過電流保護動作時にフィードバック端子の電圧低下を検出すると、出力電圧を停止した状態になります。

ソフトスタート動作中は、フィードバック端子電圧の検出による出力電圧の停止を行いません。このためイネーブル端子または入力電圧投入後の、ソフトスタート動作により出力電圧の供給が開始されます。

低電圧保護機能

本製品は低電圧保護機能を内蔵しており、制御部入力電圧 V_{IN2} が低電圧保護解除電圧 $V_{UVR} = 2.55\text{V}$ （標準）を超えると、出力電圧 V_{OUT} の供給を開始します。低電圧保護機能は 0.1V（標準）のヒステリシス特性を持っており、制御部入力電圧 V_{IN2} が低電圧保護検出電圧 $V_{UV} = 2.45\text{V}$ （標準）以下になると出力電圧の供給を停止します。

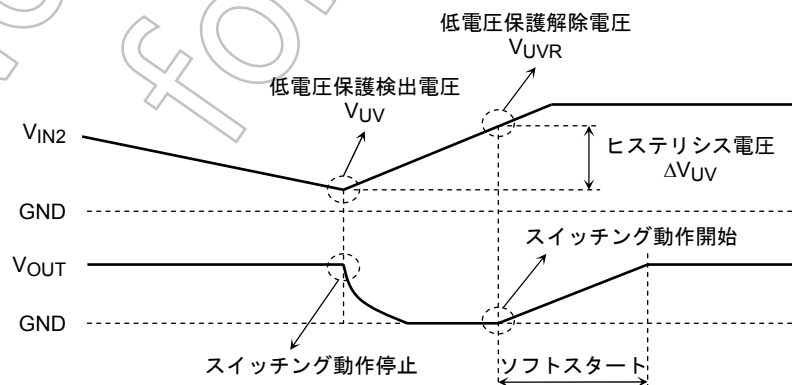


図4 低電圧保護動作

過熱保護機能

本製品は過熱保護機能を内蔵しています。接合部温度 T_j が過熱保護検出温度 $T_{SD} = 150^{\circ}\text{C}$ (標準) 以上となると過熱保護回路が作動して、出力電圧の供給を停止します。過熱保護回路は 15°C (標準) のヒステリシス特性を持ち、過熱保護が作動した後、接合部温度が 15°C 程度低下すると過熱保護が解除され、ソフトスタート動作を経て出力電圧の供給を再開します。

過熱保護機能はシステム異常時の安全性を高めるための機能であり、通常の動作状態で過熱保護が作動するような使用条件は避けてください。

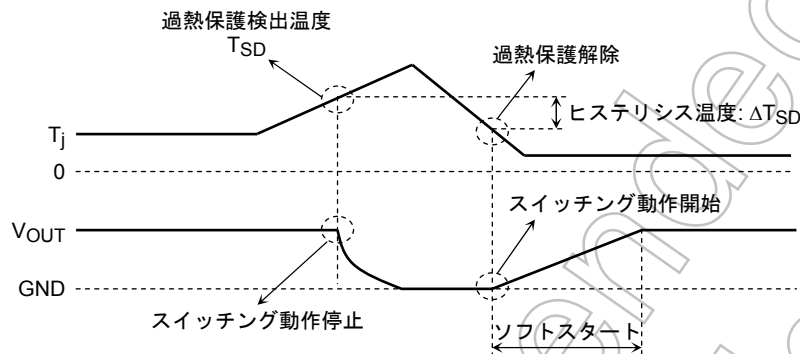
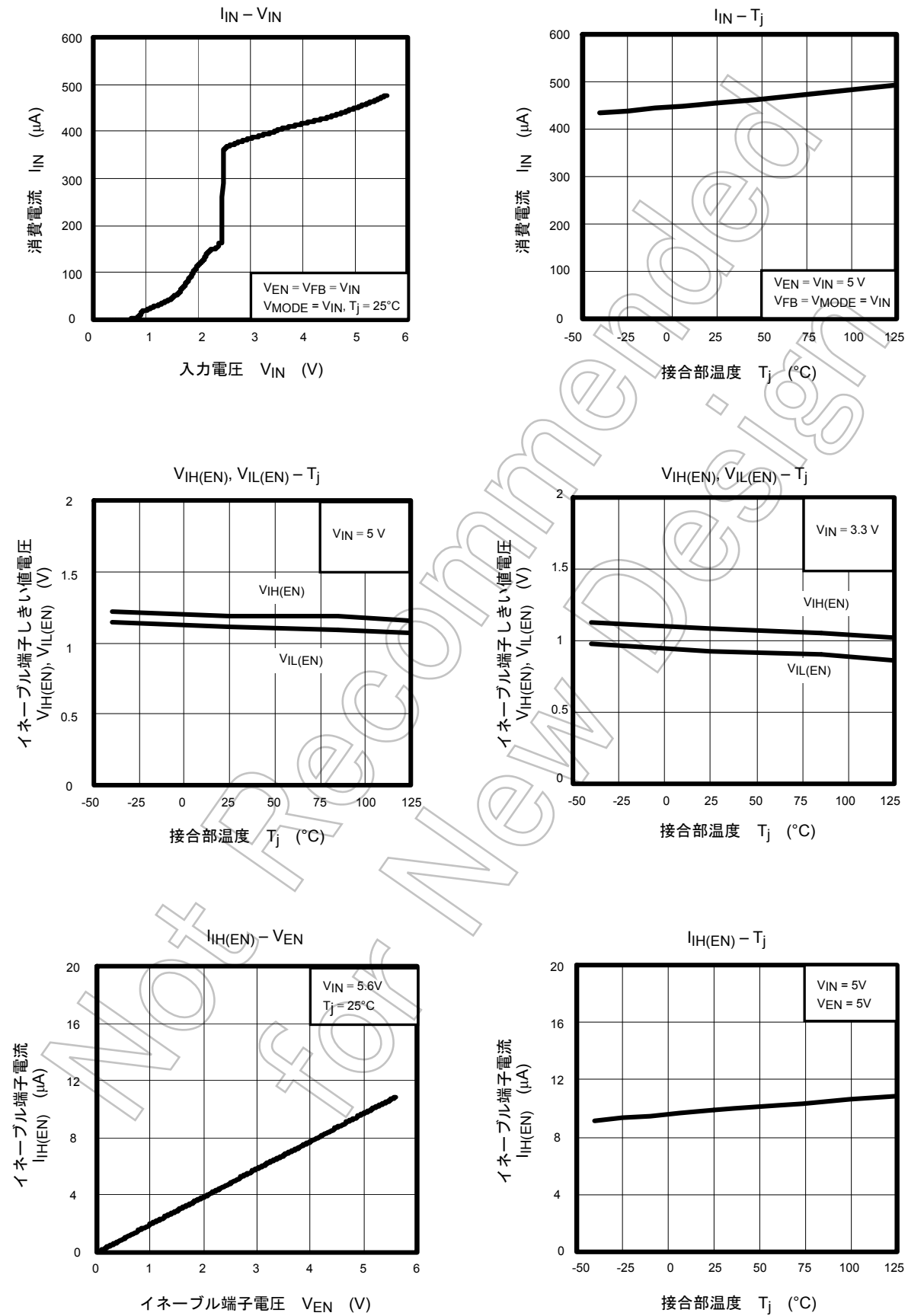


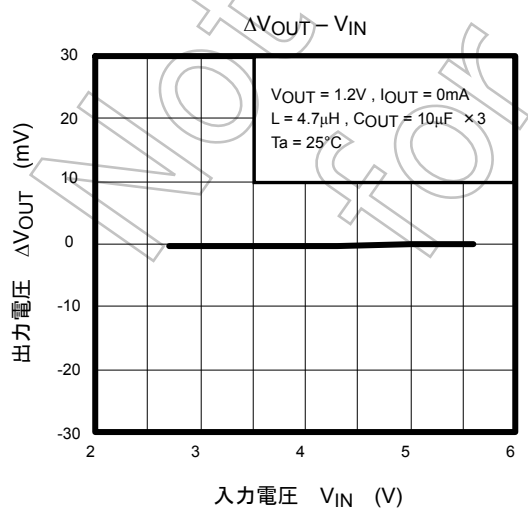
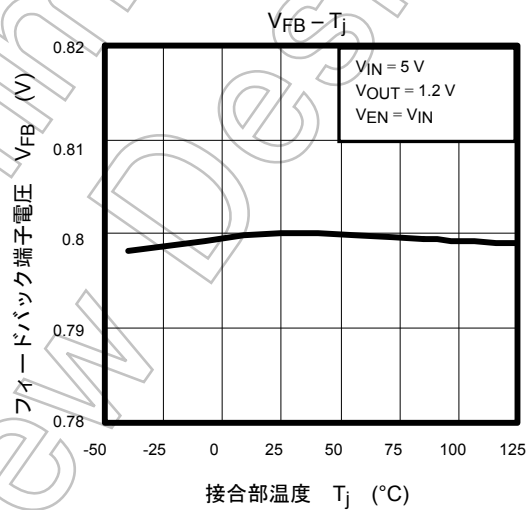
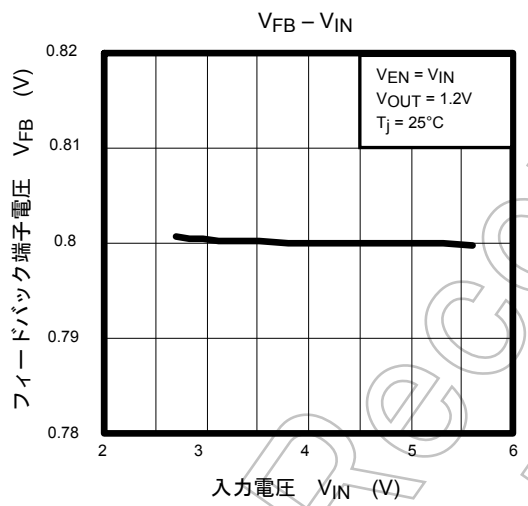
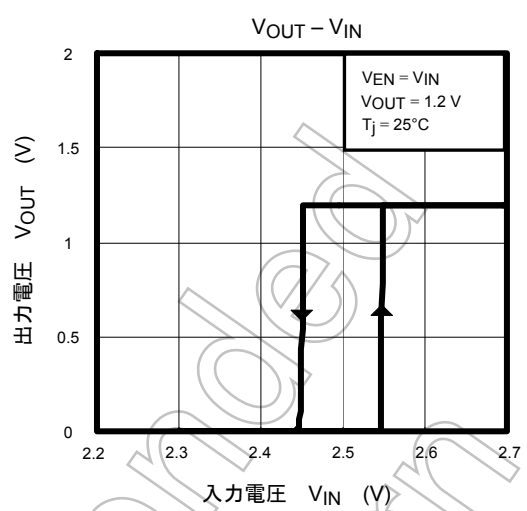
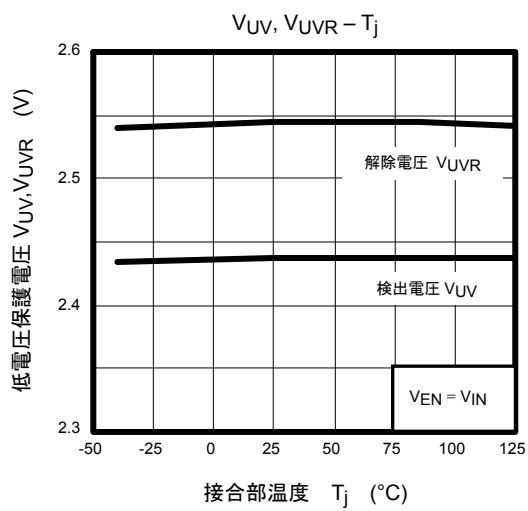
図 5 過熱保護動作

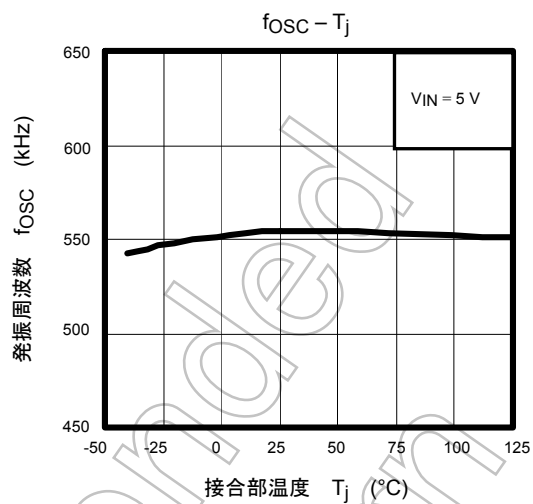
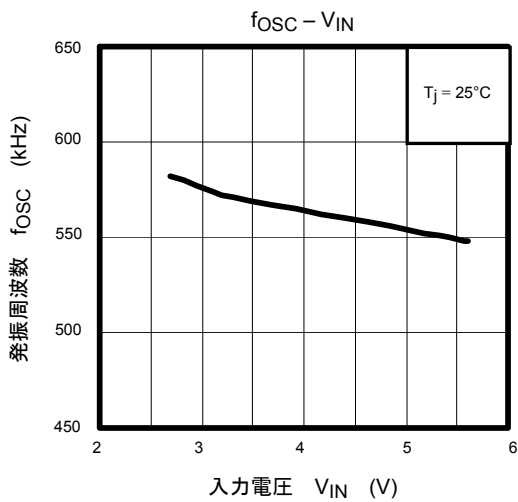
使用上の注意

- ご使用になる入力電圧、出力電圧、出力電流、温度、コンデンサ、インダクタ、抵抗の種類や特性を十分考慮の上、最終的にはご使用になるセットで実際に動作確認して部品選定をしてください。
- 本製品の周辺部品として記載されている製品は代表的な使用例を示すもので、供給が不可能となる場合があります。ご使用になる場合は最新の情報を確認してください。
- コンデンサ、インダクタ、抵抗等の周辺部品は本製品の出来る限り近い場所に配置してください。
- イネーブル端子と制御部入力端子間には、静電気保護用ダイオードが内蔵されています。イネーブル端子と制御部入力端子間電圧は $V_{EN} - V_{IN2} < 0.3\text{V}$ となるようにご使用ください。
- C_{IN} は V_{IN1} 端子と $PGND$ 端子の直近に接続してください。基板レイアウト等の影響により動作が不安定になることがあります。その場合には $SGND$ 端子と V_{IN2} 端子の間に直近に $0.1\mu\text{F} \sim 1\mu\text{F}$ 程度のデカップリングコンデンサ C_C を接続してください。
- 最小設定可能出力電圧は 0.8V (標準) です。入出力電位差が小さくなると、レギュレーション動作が十分に行われなくなり、出力電圧の変動が大きくなる場合があります。
- 本製品はスイッチング端子 (Lx) に、インダクタの回生電流が流れるため、動作時に負電圧が発生します。スイッチング素子のデッドタイムの間、ローサイド素子の寄生ダイオードに電流が流れますが、製品の動作として許容され、同期整流モード ($MODE=H$) のみで使用する場合には、外付けのフライホイールダイオードは省略できます。外部から負電圧が印加される可能性がある場合には、製品保護のため、ダイオードを追加してください。チョップモード ($MODE=L$) で使用する場合は、ローサイド素子にショットキバリアダイオードが必要です。
- 本製品の $SGND$ 端子 (4 番ピン) は IC チップの裏面に接続され放熱する構造となっています。放熱のために十分な GND パターンの面積を確保するようにしてください。
- 本製品の過電流保護回路は短時間かつわずかな程度に過剰な電流から一時的に本製品を保護するものであり、どのような場合でも本製品を保護するわけではありません。過電流保護動作後は直ちに過電流状態を解除するようお願いします。絶対最大定格を超えた場合など、ご使用方法や状況により、過電流保護回路が正常に動作しなかったり、動作する前に本製品が破壊したりすることがあります。
- 過熱保護回路は短時間かつわずかな程度に過剰な熱から一時的に本製品を保護するものであり、どのような場合でも本製品を保護するわけではありません。過熱保護動作後は、速やかに過熱状態を解除するようお願いします。絶対最大定格を超えて使用した場合など、ご使用方法や状況により、過熱保護回路が正常に動作しなかったり、動作する前に本製品が破壊したりすることがあります。

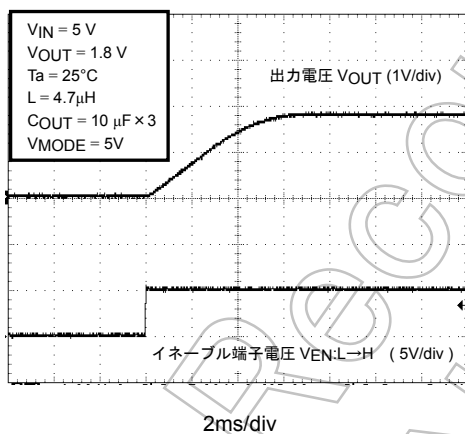
特性グラフ



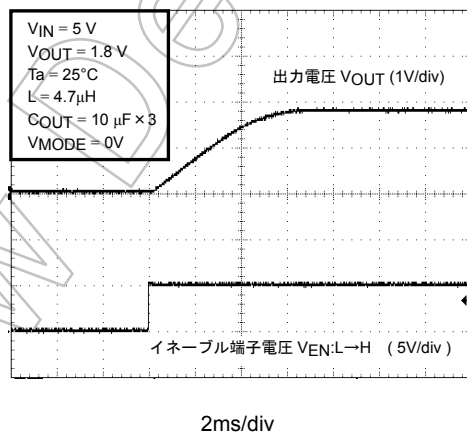


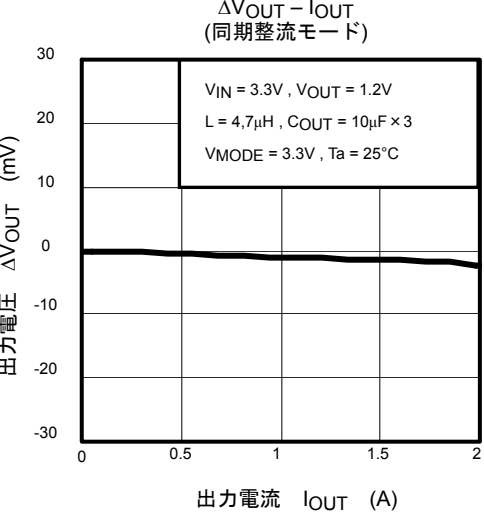
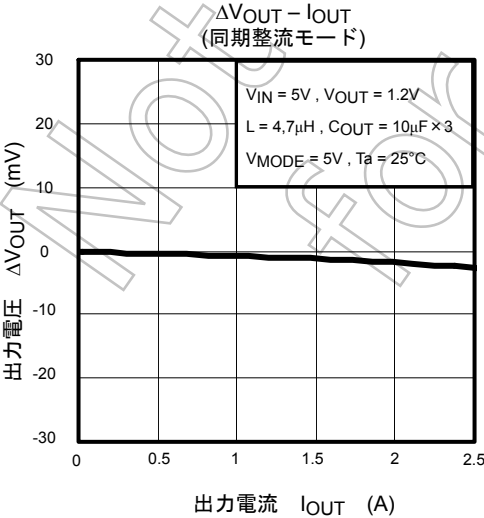
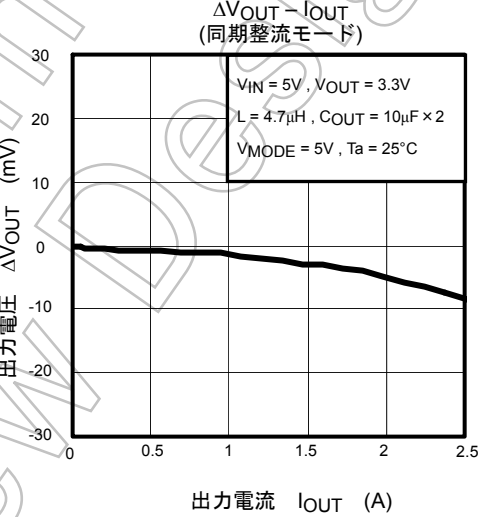
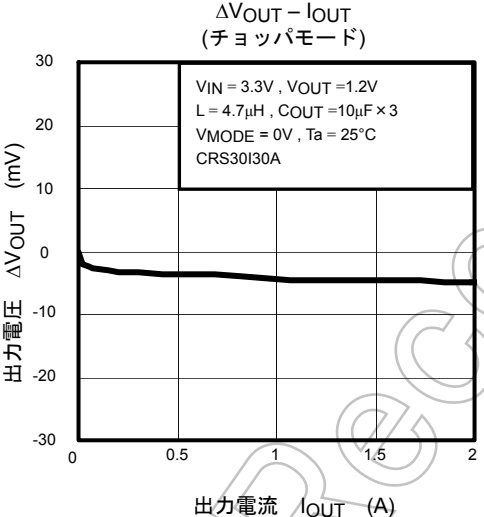
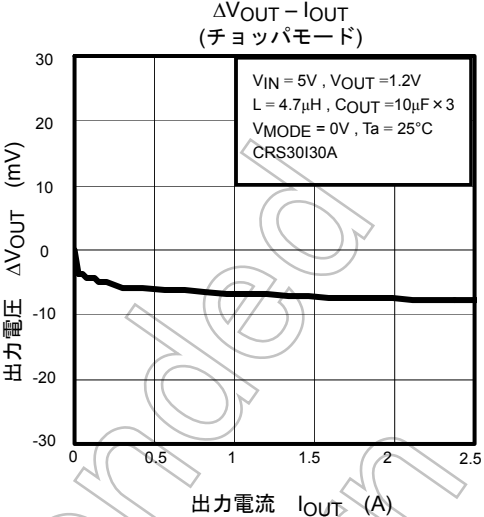
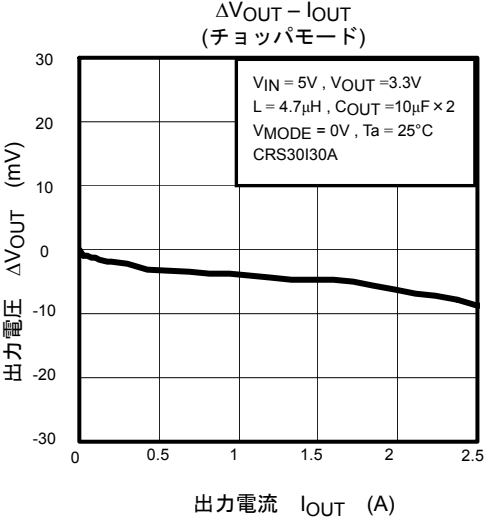


起動特性
(同期整流モード ソフトスタート時間)

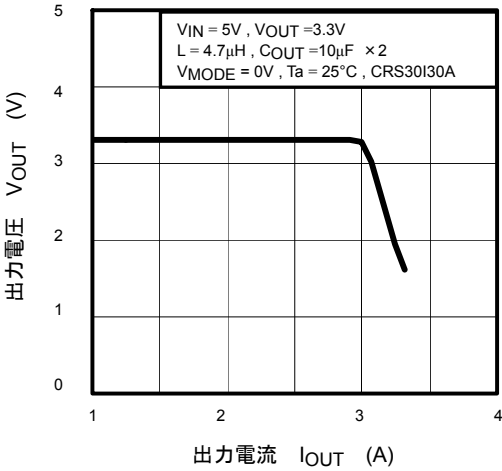


起動特性
(チョップパモード ソフトスタート時間)

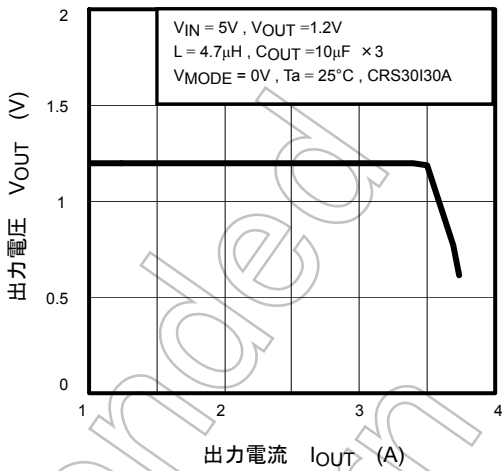




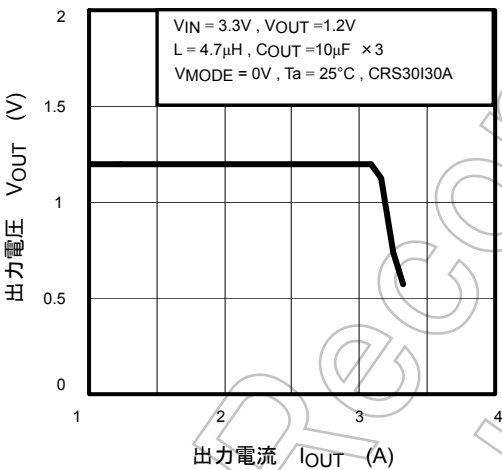
過電流特性
(チョップモード)



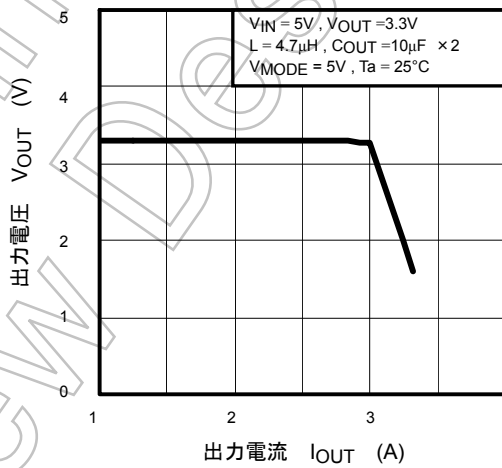
過電流特性
(チョップモード)



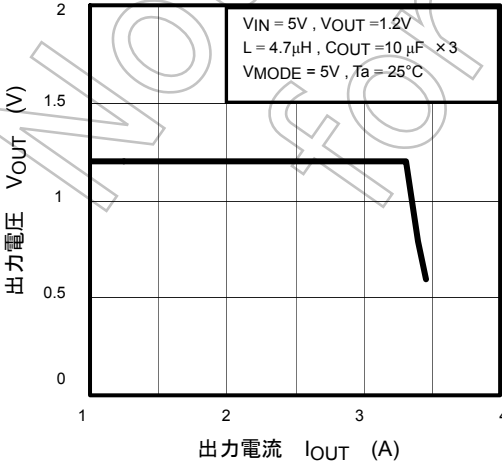
過電流特性
(チョップモード)



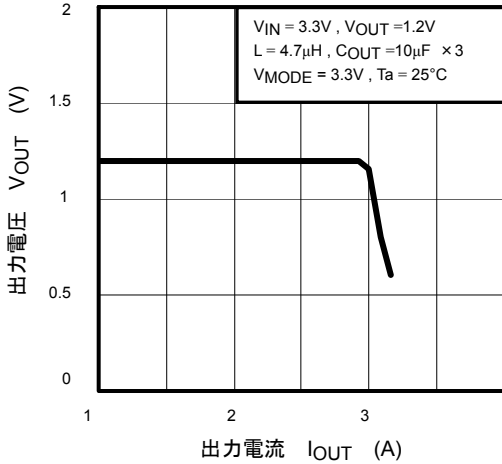
過電流特性
(同期整流モード)

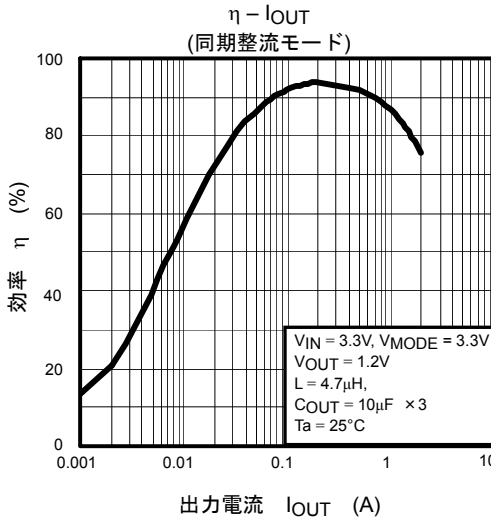
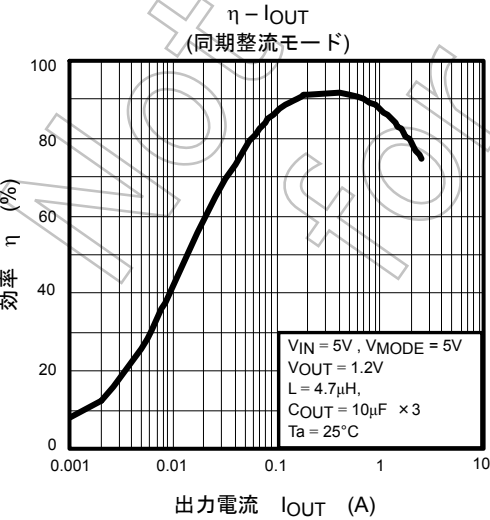
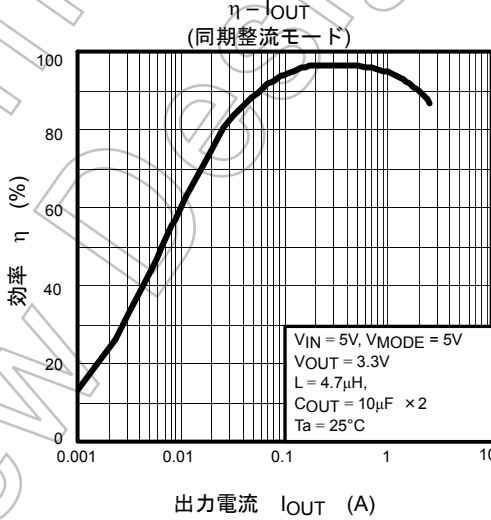
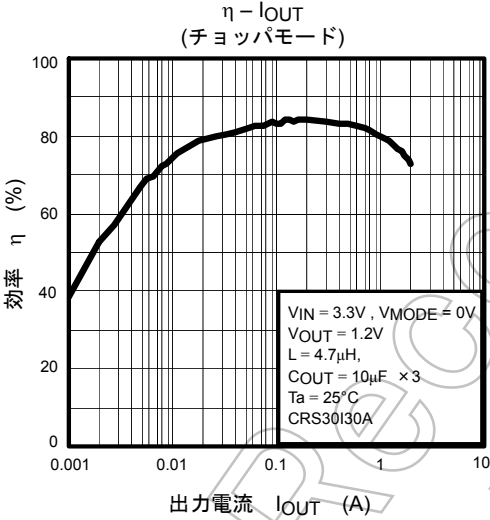
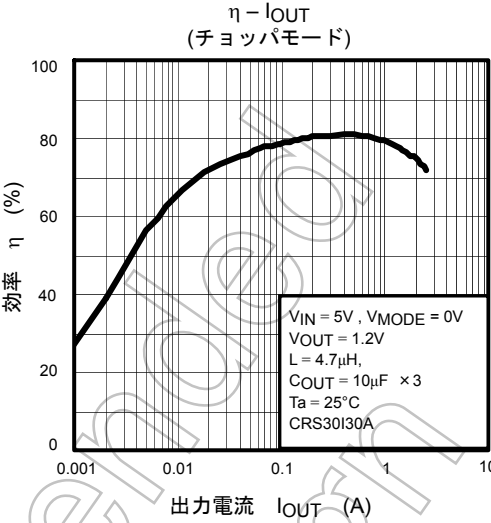
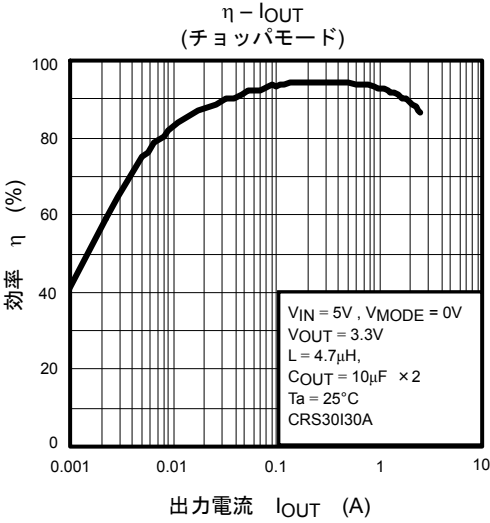


過電流特性
(同期整流モード)

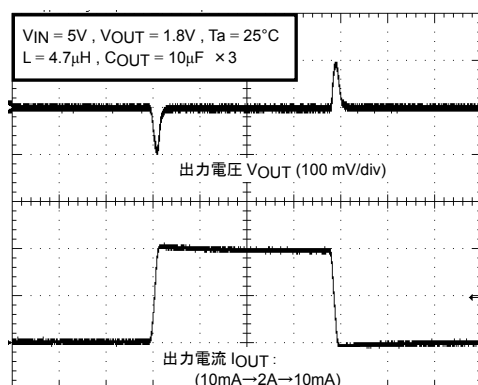


過電流特性
(同期整流モード)

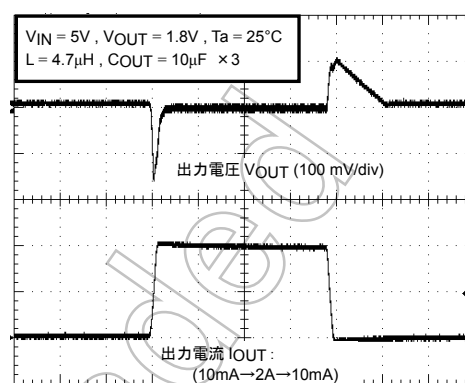




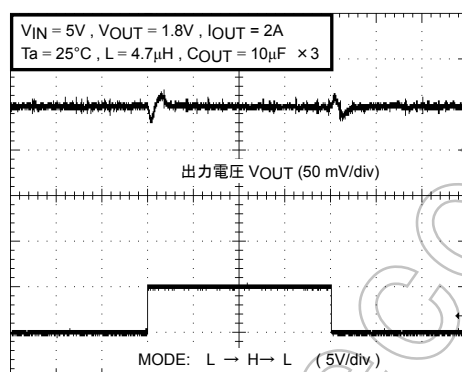
負荷応答特性
(同期整流モード)



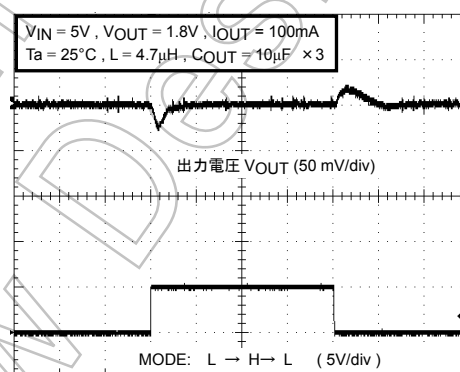
負荷応答特性
(チョップパモード)



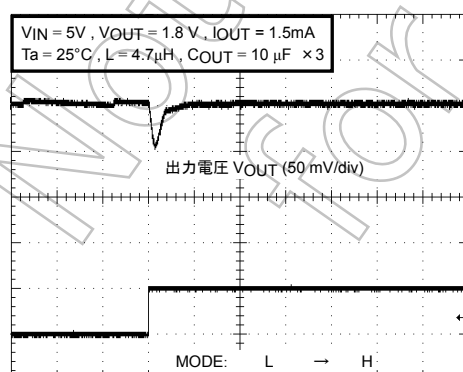
モード切替 $I_{OUT} = 2A$
(チョップパ→同期整流→チョップパ)



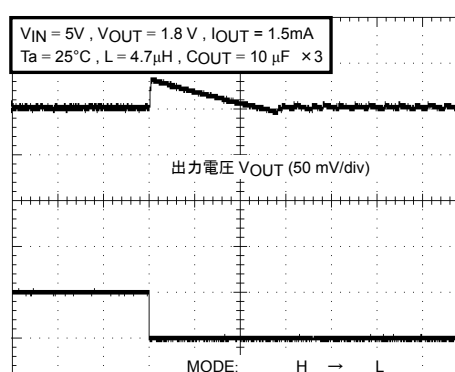
モード切替 $I_{OUT} = 100mA$
(チョップパ→同期整流→チョップパ)



モード切替 $I_{OUT} = 1.5mA$
(チョップパ→同期整流)



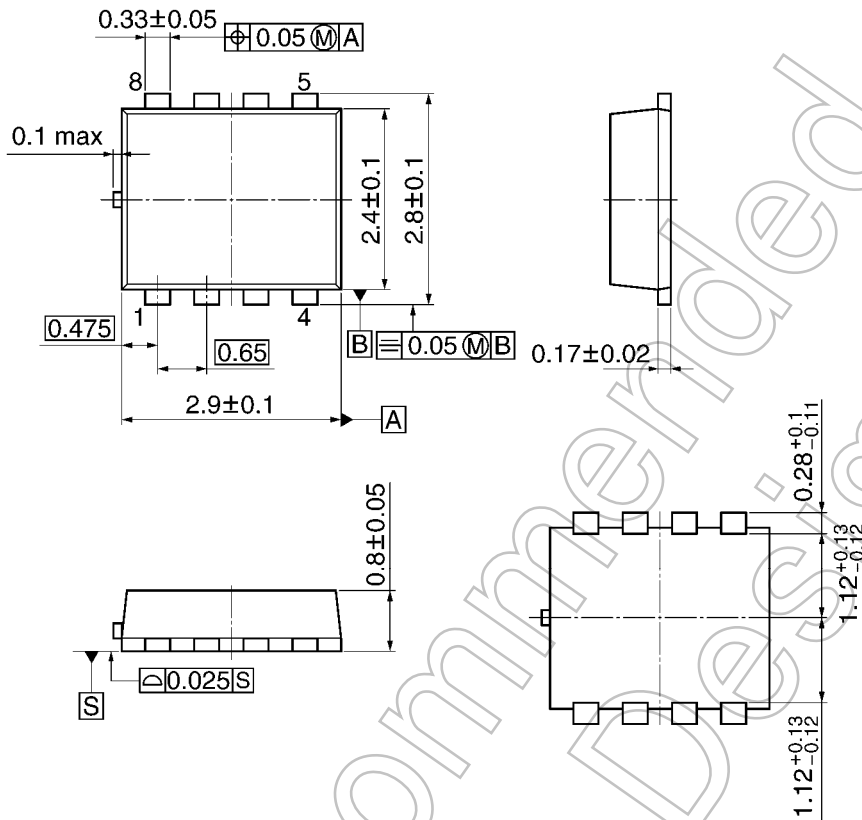
モード切替 $I_{OUT} = 1.5mA$
(同期整流→チョップパ)



外形寸法図

SON8-P-0303-0.65A

Unit: mm



質量: 0.017 g (標準)

製品取り扱い上のお願い

- 本資料に掲載されているハードウェア、ソフトウェアおよびシステム（以下、本製品という）に関する情報等、本資料の掲載内容は、技術の進歩などにより予告なしに変更されることがあります。
- 文書による当社の事前の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。また、文書による当社の事前の承諾を得て本資料を転載複製する場合でも、記載内容に一切変更を加えたり、削除したりしないでください。
- 当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体・ストレージ製品は一般に誤作動または故障する場合があります。本製品をご使用頂く場合は、本製品の誤作動や故障により生命・身体・財産が侵害されることのないように、お客様の責任において、お客様のハードウェア・ソフトウェア・システムに必要な安全設計を行うことをお願いします。なお、設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報（本資料、仕様書、データシート、アプリケーションノート、半導体信頼性ハンドブックなど）および本製品が使用される機器の取扱説明書、操作説明書などをご確認の上、これに従ってください。また、上記資料などに記載の製品データ、図、表などに示す技術的な内容、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの情報を使用する場合は、お客様の製品単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
- 本製品は、特別に高い品質・信頼性が要求され、またはその故障や誤作動が生命・身体に危害を及ぼす恐れ、膨大な財産損害を引き起こす恐れ、もしくは社会に深刻な影響を及ぼす恐れのある機器（以下“特定用途”という）に使用されることは意図されていませんし、保証もされていません。特定用途には原子力関連機器、航空・宇宙機器、医療機器、車載・輸送機器、列車・船舶機器、交通信号機器、燃焼・爆発制御機器、各種安全関連機器、昇降機器、電力機器、金融関連機器などが含まれますが、本資料に個別に記載する用途は除きます。特定用途に使用された場合には、当社は一切の責任を負いません。なお、詳細は当社営業窓口までお問い合わせください。
- 本製品を分解、解析、リバースエンジニアリング、改造、改変、翻案、複製等しないでください。
- 本製品を、国内外の法令、規則及び命令により、製造、使用、販売を禁止されている製品に使用することはできません。
- 本資料に掲載してある技術情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。
- 別途、書面による契約またはお客様と当社が合意した仕様書がない限り、当社は、本製品および技術情報に関して、明示的にも黙示的にも一切の保証（機能動作の保証、商品性の保証、特定目的への合致の保証、情報の正確性の保証、第三者の権利の非侵害保証を含むがこれに限らない。）をしておりません。
- 本製品、または本資料に掲載されている技術情報を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的、あるいはその他軍事用途の目的で使用しないでください。また、輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」、「米国輸出管理規則」等、適用ある輸出関連法令を遵守し、それらの定めるところにより必要な手続を行ってください。
- 本製品の RoHS 適合性など、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問い合わせください。本製品のご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用ある環境関連法令を十分調査の上、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いかねます。